SOT23 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

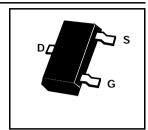
VN10LF

ISSUE 2 – JANUARY 1996

FEATURES

- * 60 Volt V_{DS}
- * $R_{DS(on)} = 5\Omega$

PARTMARKING DETAIL - MY



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

| PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------|
| Drain-Source Voltage | V _{DS} | 60 | V |
| Continuous Drain Current at T _{amb} = 25°C | I _D | 150 | mA |
| Pulsed Drain Current | I _{DM} | 3 | Α |
| Gate Source Voltage | V _{GS} | ± 20 | V |
| Power Dissipation at T _{amb} = 25°C | P _{tot} | 330 | mW |
| Operating and Storage Temperature Range | T _j :T _{stg} | -55 to +150 | °C |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C unless otherwise stated).

| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT | CONDITIONS. | |
|------------------------------------------------|---------------------|------|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Drain-Source Breakdown Voltage | BV _{DSS} | 60 | | | V | $I_D = 100 \mu A, V_{GS} = 0 V$ | |
| Gate-Source Breakdown Voltage | V _{GS(th)} | 8.0 | | 2.5 | V | $I_D=1mA$, $V_{DS}=V_{GS}$ | |
| Gate Body Leakage | I _{GSS} | | | 100 | nA | V_{GS} =± 20V, V_{DS} =0V | |
| Zero Gate Voltage Drain Current (1) | I _{DSS} | | | 10 | μΑ | V _{DS} =60 V, V _{GS} =0V | |
| On State Drain Current(1) | I _{D(on)} | 750 | | | mA | V _{DS} =15 V, V _{GS} =10V | |
| Static Drain Source On State Resistance (1) | R _{DS(on)} | | | 5.0 7.5 | Ω Ω | V _{GS} =10V, I _D =500mA V _{GS} =5V, I _D =200mA | |
| Forward Transconductance (1)(2) | g _{fs} | 100 | | | mS | V _{DS} =15V, I _D =500mA | |
| Input Capacitance (2) | C _{iss} | | | 60 | pF | | |
| Common Source Output Capacitance (2) | C _{oss} | | | 25 | pF | V _{DS} =25 V, V _{GS} =0V f=1MHz | |
| Reverse Transfer Capacitance (2) | C _{rss} | | | 5 | pF | | |
| Turn-On Time (2)(3) | t _(on) | | 3 | 10 | ns | | |
| Turn-Off Time (2)(3) | t _(off) | | 4 | 10 | ns | V _{DD} ≈15V, I _D =600mA | |

⁽¹⁾ Measured under pulsed conditions. Width=300µs. Duty cycle ≤2% (2) Sample test.

⁽³⁾ Switching times measured with 50Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator Spice parameter data is available upon request for this device For typical characteristics graphs see ZVN3306F datasheet.



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331